

**КТ8248А, А1**  
п-р-п кремниевый  
эпитаксиально-планарный  
высоковольтный транзистор

### Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы (КТ8248А1 с демпфирующим диодом и резистором в цепи эмиттер-база). Предназначены для применения в высоковольтных ключевых схемах телевизионных приемников, а также в узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

### Зарубежный прототип

- Прототип – BU2506D

### Особенности

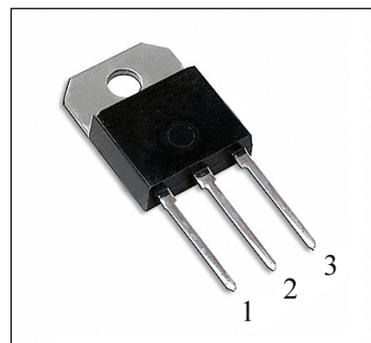
- Диапазон рабочих температур от - 25 до + 125°С

### Обозначение технических условий

- АДБК.432.140.903 ТУ

### Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-43 (ТО-218)



### Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	База
№2	Коллектор
№3	Эмиттер

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ8248 при  $T_{окр. среды} = 25^{\circ}C$** 

Параметры	Обозн.	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор-эмиттер	Укэо гр.	В	$I_k=100mA, I_b=0, L=40 мГн$	700	-
Обратный ток коллектор-эмиттер	Ikэк	мА	Укэк =1500В Убэ=0	-	1,0
Обратный ток эмиттера КТ8248А КТ8248А1	Iэбо	мА	Уэб=7,5В; Ik=0	95	1,0 208
Статический коэффициент передачи тока * КТ8248А* <sup>1</sup> КТ8248А1* <sup>1</sup>	h21э		Укэ=5В, Ik=3А, $t_{и} \leq 300 мс, Q \geq 100$ Укэ=5В, Ik=0,3А, $t_{и} \leq 300 мкс, Q \geq 100$	3,8 - -	9,0 60 30
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Укэ(нас)	В	$I_k=3 А, I_b=0,79 А, t_{и} \leq 300 мкс, Q \geq 100$	-	3,0
Напряжение насыщения база-эмиттер	Убэ(нас)	В	$I_k=3 А, I_b=0,79 А, t_{и} \leq 300 мкс, Q \geq 100$	-	1,1
Сопротивление резистора эмиттер-база КТ8248А1* <sup>1</sup>	Рэб	Ом	Уэб=7,5 В, Ik=0	35	80
Емкость коллекторного перехода* <sup>1</sup>	Ск	пФ	Укб=10 В, f=1 МГц	-	90
Время спада * <sup>1</sup> Время рассасывания * <sup>1</sup>	tсп. трас.	мкс	Ук=500В, Ik =3 А I <sub>Б1</sub> =0,67А, I <sub>Б2</sub> =-1,3А	-	0,5 6,0
Постоянное прямое напряжение диода КТ8248А1	Uпр.	В	Iпр=3 А, $t_{и} \leq 300 мкс, Q \geq 100$		2,0

\* В схеме с общей базой – Укб=3,9 В, Iэ=3,5А

\*<sup>1</sup> Справочные параметры

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ8248**

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значен.
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Уэб=0)	Укэк max	В	1500
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	Укэ max	В	700
Постоянное напряжение эмиттер-база	Уэб max	В	7,5
Постоянный ток коллектора (при условии неперевышения $R_k max$ и при $U_{кэ} \leq 18 В$ )	$I_k max$	А	5
Импульсный ток коллектора ( $t_{и} \leq 10 мс$ )	$I_k и max$	А	8
Постоянный ток базы	$I_b max$	А	3
Импульсный ток базы ( $t_{и} \leq 10 мс$ )	$I_b и max$	А	5
Запирающий ток базы (средний за 20 мс)	$I_b зап. max$	мА	100
Импульсный запирающий ток базы	$I_b зап. и max$	А	4
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_{корп} \leq 25^{\circ}C$	$R_k max$	Вт	90
Температура перехода	$T_{пер.max}$	$^{\circ}C$	150
Тепловое сопротивление переход-корпус	$R_{tпер-корп}$	$^{\circ}C/Вт$	1,39



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>